Lucerne University of Applied Sciences and Arts

HOCHSCHULE LUZERN

Technik & Architektur

ET+V

Elektrotechnik Vertiefung

HSLU T&A

Strömungsfeld 13.7.2013

Lernziele

 Sie kennen den Begriff el. Strömungsfeld und seine Kenngrössen

Leitungsmechanismen – 1

- Um den Atomkern aus Protonen und Neutronen kreisen die Elektronen auf bestimmten Bahnen, die diskreten Energiestufen entsprechen.
- Die Elektronen der unvollständig besetzten äussersten Schale sind die Valenzelektronen.
- Die Rumpfelektronen sind diejenigen der darunter liegenden Schalen.
- Durch die Wechselwirkung mehrerer Atome entstehen Energiebänder, welche durch verbotene Zonen getrennt werden. Das höchste Band ist das Valenzband. Darüber befindet sich das Leitungsband, in dem sich die Elektronen frei bewegen können.
- Voraussetzung el. Leitung: freie Ladungsträger
 - Elektronen: $-e = -1,602 \cdot 10^{-19} C$ (Coulomb, 1C = 1As)
 - Protonen: $e = 1,602 \cdot 10^{-19} C$
 - lonen:
 - entfernen von Elektronen aus der Atomhülle ⇒ positives Ion
 - hinzufügen von Elektronen in die Atomhülle ⇒ negatives Ion

Leitungsmechanismen – 2: Isolatoren

- Beispiele:
 - Vakuum, Luft
 - Gase (keine freien Elektronen): SF6
 - Flüssigkeiten: Transformatorenöl
 - Festkörper: Glas, Keramik, Quarz, Glimmer, Bernstein, Papier, Kunststoffe
- Zwischen dem Valenzband und dem Leitungsband befindet sich eine Energielücke (verbotene Zone): $\Delta W > 5eV$ $1eV = 1.602 \cdot 10^{-19} J$
- Nur wenige Valenzelektronen besitzen genug Energie um ins Leitungsband zu gelangen.

Leitungsmechanismen – 3: Halbleiter

- Beispiele:
 - Elemente: Kohlenstoff (C), Selen (Se),
 Germanium (Ge), Silizium (Si)
 - Verbindungen: Galliumarsenid (GaAs),
 Indiumantimonid (InSb), Zinkoxid (ZnO)
- Die Energielücke ist kleiner als bei den Isolatoren $\Delta W < 5eV$
- Ladungsträger können Elektronen (n-Leiter) oder Defektelektronen (p-Leiter, Löcher) sein.
- Anwendungen: Diode, Transistor, Thyristor, Photozellen

Leitungsmechanismen – 4: Leiter

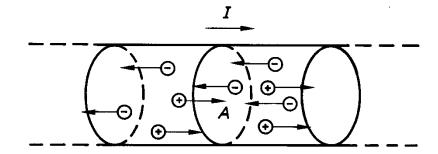
- Beispiele:
 - Metalle (freie Elektronen):
 Silber (Ag), Kupfer (Cu), Gold (Au),
 Aluminium (Al)
 - Gase (bei hohen Temperaturen ionisiert):
 Plasma
 - Flüssigkeiten (positive und negative Ionen):
 verdünnte Säuren und Basen,
 wässrige Salzlösungen und Salzschmelzen
- Bei Metallen überschneiden sich das Valenzund das Leitungsband, so dass Elektronen ungehindert vom Valenz- ins Leitungsband gelangen können, d.h. sie können sich frei zwischen den ortsfesten Atomrümpfen des Kristallgitters bewegen.

Strom und Stromdichte - 1

Strom I:

$$I = \frac{Ladungsmenge durch Kontroll - Querschnitt A}{Zeiteinheit} \qquad [I] = \frac{A \cdot S}{S} = A$$

$$[I] = \frac{A \cdot S}{S} = A$$



Stromdichte J im homogenen Feld: $J = \frac{I}{A} \left| \frac{A}{mm^2} \right|$

$$J = \frac{I}{A} \left[\frac{A}{mm^2} \right]$$

$$\left| \vec{J} \right| = \frac{dI}{dA} \left[\frac{A}{mm^2} \right]$$

Stromdichte im inhomogenen Feld: $|\vec{J}| = \frac{dI}{dA} \left[\frac{A}{mm^2} \right]$ Stromdichte hängt von Ort und Richtung ab (\rightarrow vektorielle Grösse)

Strom und Stromdichte - 2

$$\left| \vec{J} \right| = \frac{dI}{dA} \left| \frac{A}{mm^2} \right|$$

Stromdichte im inhomogenen Feld: $|\vec{J}| = \frac{dI}{dA} \left[\frac{A}{mm^2} \right]$ Stromdichte hängt von Ort und Richtung ab (\rightarrow vektorielle Grösse)

Über Fläche A, nach dem Strom aufgelöst:

$$I = \int\limits_A \vec{J} d\vec{A} \, \left[A\right]$$
 Strom durch Fläche A

Vergl. PV-Generator Einstrahlung, Ausrichtung PV-Modul

Typische Stromdichten: Niederspannungsverteilung 2..10 A/mm²

Begrenzt durch Maximaltemperatur der Isolation



Auswirkung auf PVC-Isolation Bei Stromdichte J = 120 A/mm²

Elektrisches Strömungsfeld

- Das Feld erstreckt sich zwischen 2 Elektroden, die an einer Spannungsquelle angeschlossen sind.
- Ursache der Ladungsbewegung: el. Spannung zwischen den Elektroden, im Feld drinnen ist es die elektrische Feldstärke
- Feld beschreibt Ladungsbewegung in elektrischem Leiter. Ladungsträger folgen der elektrischen Feldstärke \vec{E} , d.h. den Feldlinien
- Wirkung ist die Ladungsbewegung, gemessen mit der Stromdichte \vec{J}

Ohmsches Gesetz im elektrischen Strömungsfeld

$$\vec{E} = \rho \cdot \vec{J}$$

Das ohmsche Gesetz gilt auch "lokal":

Elektrische Feldstärke

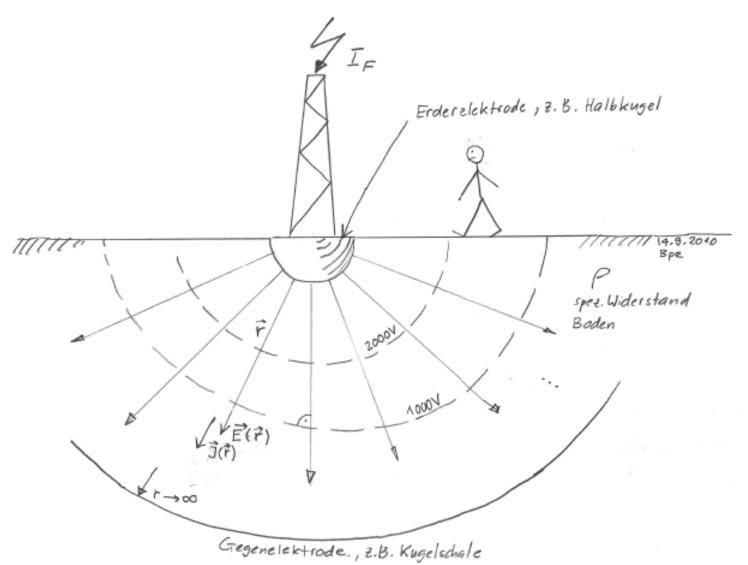
$$[\vec{E}] = \frac{V}{m}$$

Stromdichte

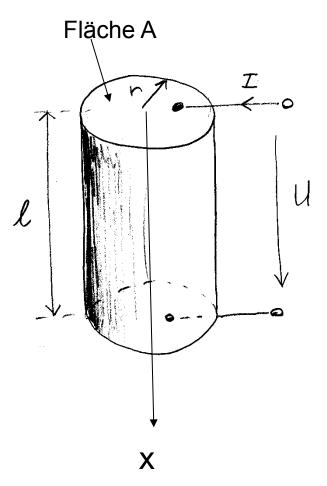
$$\left[\vec{J}\right] = \frac{A}{mm^2}$$

$$\left[\rho\right] = \frac{\Omega mm^2}{m} = 10^{-6} \Omega m$$

Strömungsfeld Beispiel-1



Strömungsfeld Beispiel-2



Konstanter spezifischer Widerstand ρ Ideale "Elektrodenflächen": Parallele kreisrunde Flächen, homogenes Feld

$$I = \int_{A} \vec{J} \cdot d\vec{A} = J \int_{A} dA = J \cdot \pi \cdot r^{2}$$

$$\Rightarrow J = \frac{I}{\pi \cdot r^{2}} \Rightarrow E(x, r) = E = \rho \cdot J = \frac{I \cdot \rho}{\pi \cdot r^{2}}$$

$$U = \int_{0}^{l} E \cdot dx = \frac{I \cdot \rho}{\pi \cdot r^{2}} \int_{0}^{l} dx = \frac{I \cdot \rho \cdot l}{\pi \cdot r^{2}}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\frac{I \cdot \rho \cdot l}{\pi \cdot r^2}}{I} = \frac{\rho \cdot l}{\pi \cdot r^2} = \frac{\rho \cdot l}{A} [\Omega]$$

Strömungsgeschwindigkeit v der Ladungsträger - 1

Abschätzung in geradem Kupferleiter mit Querschnitt A (Homogenes Strömungsfeld)

Beispiel: I = 4A, Kupferleiter 1.5mm^2 n = Anzahl freie Elektronen pro Volumeneinheit = $8.47 \cdot 10^{19} \text{ mm}^{-3}$

Anzahl Ladungen in Leiterlänge dl:

$$dQ = n \cdot e \cdot A \cdot dl$$
, $[A] = mm^2$, $[dl] = mm$

Strömungsgeschwindigkeit v, bei einem Strom I

$$I = \frac{dQ}{dt} = n \cdot e \cdot A \cdot \frac{dl}{dt} = n \cdot e \cdot A \cdot v, \quad [A] = mm^2, [dl] = mm, [v] = \frac{mm}{s}$$

$$\Rightarrow v = \frac{I}{n \cdot e \cdot A} = 0.2 \frac{mm}{s}$$

Aber: Signalgeschwindigkeit ist ca. 300'000 km/s!

Skript G2,S3

Repetition

- Wie lautet das ohmsche Gesetz mit den lokalen Grössen (Vektoren)?
- Was versteht man unter Stromdichte? Welche Einheit hat sie? Grössenordnung für Niederspannungsverteilung?